

# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIA

### **SYLLABUS**

# INGENIERÍA ELECTRÓNICA

NOMBRE DEL DOCENTE:								
ESPACIO ACADÉMICO (Asi	gnatura):							
Física de Sen	gópygo sosoo							
Obligatorio (x): Básico (x) (	<b>CÓDIGO:</b> 507002							
Electivo (): Intrínsecas () Ext								
NUMERO DE ESTUDIANTES:	GRUPO:							
	NÚMERO DE CREDITOS: 3	3						
TIPO DE CURSO:	TEÓRICO X PRACTIC	O TEO-PRAC:						
	<del></del>							
Alternativas metodológicas:								
	( ), Seminario – Taller ( ), T	Caller ( ), Prácticas ( ), Proyectos						
tutoriados ( ), Otro:								
HORARIO:								
DIA	HORAS	SALON						
	USTIFICACIÓN DEL ESPACIO							
La electrónica es la ciencia que es	tudia la interacción entre los elec-	trones y otras partículas cargadas con						
campos eléctricos, magnéticos y el	lectromagnéticos, y se basa en la	física de los dispositivos electrónicos						
y equipos (al vacío, semiconductores y otros), utilizados para la transmisión, procesamiento y								
almacenamiento de la información.								
Las principales orientaciones de de	esarrollo de la electrónica son: va	acío, de estado sólido y la electrónica						
cuántica.								
La Física de Semiconductores es	tudia los problemas relacionado	s con las propiedades de materiales						
sólidos (semiconductores, dieléctr	icos, etc.), la influencia de las i	mpurezas en estas propiedades y las						

características estructurales del material de estudio, las propiedades de superficies e interfaces entre las capas de diferentes materiales, la creación de regiones del cristal con diferente conductividad, la creación de heterouniones, la creación de dispositivos de microelectrónicos y nanoelectrónicos (nanoelectrónica). Las principales áreas de la electrónica de estado sólido son: electrónica de semiconductores asociados con el desarrollo de varios tipos de dispositivos semiconductores y la microelectrónica asociados con el desarrollo de circuitos integrados.

#### II. PROGRAMACION DEL CONTENIDO

#### **OBJETIVO GENERAL**

Conocer las propiedades eléctricas, ópticas de los sólidos desde las leyes de la Física Moderna y la Mecánica Cuántica

Estudiar y valorar el efecto de los parámetros físicos (temperatura, concentración de impurezas, etc.) sobre las propiedades eléctricas y ópticas de los materiales

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer, entender y resolver problemas de Física Moderna

Estudiar la ecuación de Schrödinger y sus aplicaciones

Conocer la teoría de la cristalografía básica

Estudiar las diferentes soluciones del electrón en un potencial periódico

Conocer las propiedades físicas que se derivan de la solución del electrón en un potencial periódico

Conocer el efecto del dopaje con impurezas sobre las propiedades eléctricas del material

Desarrollar un modelo de conducción eléctrica

Conocer las leyes del transporte de carga en los sólidos

Resolver problemas sobre conducción eléctrica en función de los diferentes parámetros que la afectan

Desarrollar y obtener modelos ideales y reales de dispositivos a partir de las leyes conocidas (Diodo de unión PN, BJT, FET, dispositivos optoelectrónicos)

#### RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar una comprensión de los conocimientos básicos sobre la Física Moderna.

Demostrar una comprensión de los conocimientos básicos sobre la Mecánica Cuántica.

Demostrar una comprensión de los conocimientos básicos de la Física de Semiconductores.

Demostrar habilidades de comunicación oral y escrita en la socialización de temas relacionados con los fenómenos físicos relacionados con la Física Moderna, la Mecánica Cuántica y la Física de Semiconductores.

Aplicar los fundamentos de los dispositivos de estado sólido en problemas de diseño.

Utilizar una amplia gama de recursos impresos, electrónicos y tecnologías de la información para apoyar su estudio sobre las leyes de la Física de Semiconductores y presentar esos resultados en el contexto de la comprensión actual de tales fenómenos físicos.

Demostrar una comprensión del impacto de la física y la ciencia en la sociedad.

Demostrar razonamiento lógico, práctico y estructurado en la solución de problemas.

Seleccionar, clasificar, relacionar y aplicar la información pertinente para cada caso de análisis.

Aplicar correctamente las técnicas, herramientas matemáticas y estadísticas en el análisis de problemas

Manifestar en la propuesta de soluciones un compromiso permanente con la sociedad.

Implementar nuevas metodologías y estrategias en la solución de problemas.

Demostrar una comprensión del impacto de la física y la ciencia en la sociedad.

# PROGRAMA SINTÉTICO:

FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA
INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA CUÁNTICA
ESTRUCTURA CRISTALINA
INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA ESTADÍSTICA
BANDAS DE ENERGÍA Y PORTADORES DE CARGA EN SEMICONDUCTORES
MODELOS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EN SEMICONDUCTORES
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES
NUEVOS DISPOSITIVOS

#### III: ESTRATEGIAS

## Metodología Pedagógica y Didáctica:

Las actividades del aula se fundamentan en una metodología de interacción y participación entre el profesor y los estudiantes, y de los estudiantes entre sí; las explicaciones por parte del profesor y el trabajo guiado en la solución de problemas son algunas de las acciones que nos permitan ir alcanzando los logros de manera gradual. La Física es una asignatura que exige una gran capacidad de trabajo y dedicación por parte del estudiante. Para obtener los objetivos propuestos cada estudiante debe comprometerse a desarrollar una parte del trabajo individual en casa, este componente deberá complementar el trabajo del aula.

	Hora			Horas	Horas	Total Horas	Créditos
	S			profesor/semana	Estudiante/	Estudiante/	
					semana	semestre	
Tipo de	TD	TC	TA	(TD + TC)	(TD + TC + TA)	16 semanas	
Curso							
	3	1	2	4	6	96	2

*Trabajo Presencial Directo (TD)*: trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes.

*Trabajo Mediado\_Cooperativo (TC)*: Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma individual a los estudiantes.

*Trabajo Autónomo (TA):* Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca, laboratorio, etc.)

#### IV. RECURSOS

# **Medios y Ayudas:**

Tablero, marcadores, videobeam, Aula Virtual en Moodle, computadores, etc.

#### BIBLIOGRAFÍA

#### TEXTOS GUÍA

Streetman B G. and Banerjee S., Solid state electron devices, Prentice-Hall, 2000.

Sze S. M., Physics of Semiconductor Devices. John Wiley & Sons. 1981.

### **TEXTOS COMPLEMENTARIOS**

- C. Kittel. Introduction to Solid State Physics, John Wiley & Sons.
- N. W. Ashcroft & N. D. Mermin, Solid State Physics, Holt-Saunders, Philadelphia, 1976.
- F. C. Brown, Física de los sólidos. Reverté, Barcelona, 1970.
- C. Kittel, Introducción a la física del estado sólido,. Reverté, Barcelona, 1976.
- J. P. McKelvey, Física del Estado Sólido y Semiconductores, Limusa, México, 1993.
- J. Singh. Dispositivos semiconductores, Mcgraw-Hill, 1997.
- J. Singh. Optoelectronics: An introduction to materials and devices, Mcgraw-Hill, 1996.
- O. E. Animalu. Intermedite quantum theory of cristalline solids, Prentice Hall, 1981.
- G. W. Neudeck. The PN junction diode, Modular series on solid state devices, Adisson Wesley, 1989.
- R. A. Smith. Semiconductors, Cambridge University Press. 1982.
- O. Madelung. *Physics of solid state*, Springer-Verlag, 1972.
- S. Dimitriyev. *Understanding Semiconductor Devices, The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering*, 2000.
- J. T. Verdeyen. Laser Electronics, Prentice-Hall, 1994.

Mauricio García Castañeda et al., Introducción a la Física Moderna, U. N., 1988

R. Serway, *Physics for Scientists & Engineers*, Saunders College Publishing, 3° Edition, 1990

R. Serway et al., Physics for Scientists & Engineers, Saunders College Publishing, 5° Edition., 2000

#### **ARTÍCULOS**

Levi, B. G., "What's the shape of things to come in semiconductors". *Physics Today, 45*, pp. 17+, Sep. 1992.

Bate R. T., "The quantum-effect device: Tomorrow's transistor?". *Scientific American*, 258, pp. 96-100, Mar. 1988

Capasso, F. & Datta, S., "Quantum electron devices", *Physics Today*, 43, pp. 74-82, Feb. 1992.

Chang L. L. & Esaki, L., "Semiconductor quantum heterostructures". *Physics Today, 45*, pp.36-43, Oct. 1992.

Drummund, T. J., et al, "Quantum tailored solid-states devices". IEEE Spectrum, 25, pp. 33-37, Jun. 1988.

Sundaram, M., et al., "New quantum structures". Science, 254, pp. 1326.-35, Nov. 29, 1991.

Crow, J. D., "Optical interconnects speed interprocessor nets". *IEEE Circuits and Devices Magazine*, 7, pp.20~25, Mar. 1991.

Leheny, R. E., "Optoelectronic integration: A technology for future telecommunications systems". *IEEE Circuits and devices Magazine, 5,* pp. 3841, May. 1989.

Frensley, W. R., "Gallium Arsenide transistors". Scientific American, 257, pp. 80-87, Aug. 1987.

Dambkes, H., "Gallium Arsenide HEMTs for Low-Noise GHz communication engineering". *Microelectronics journal*, 20, pp. 1-6, Sep.-Oct. 1989.

Morkoc, H., "The HEMT: A superfast transistor". IEEE Spectrum, 21, pp. 28-35, Feb. 1984.

Drummund, T J. et al., "Modulation-Doped GaAs(Al,Ga)As Heterojunction Field-Effect Transistors:

MODFETs". *Proceedings of the IEEE, 74,* pp. 773-822, Jun. 1986. **AULA VIRTUAL EN MOODLE:** 

http://ingenieria.udistrital.edu.co/moodle/course/category.php?id=23&perpage=50&page=1

# V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS

Se recomienda trabajar una unidad cada cuatro semanas, trabajar en pequeños grupos de estudiantes, utilizar Internet para comunicarse con los estudiantes para revisiones de avances y solución de preguntas (esto considerarlo entre las horas de trabajo cooperativo).

# **Espacios, Tiempos, Agrupamientos:**

	SI	EM.	AN	AS	AC	AD	ÉΜ	IC.	AS							
PROGRAMA SINTÉTICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1	1 2	1 3	1 4	1 5	16
Fundamentos de Física																
Moderna																
Radiación del cuerpo negro																
Espectros de absorción y emisión																
Series espectrales del átomo de																
hidrogeno Modelo de Bohr del átomo de																
hidrógeno																
Efecto Compton																
Efecto fotoeléctrico		-														
Propiedades ondulatorias de la materia																
Experimento de Young con un																
rayo de electrones																
Principios de incertidumbre de																
Heisenberg																
Mecánica Cuántica																
Ondulatoria																
Ecuación de Schrödinger																
Operadores mecanocuánticos																
Aplicaciones de la Ecuación de																
Schrödinger																
Introducción de la Física del																
Estado Sólido																
Elementos de cristalografía																
Difracción de Rayos X en los																
cristales																
Enlaces																
Propiedades eléctricas de los sólidos																
Comportamiento de los																
electrones en cristales																
Vibraciones de la red cristalina																
Fonones																
Mecánica cuántica de sólidos																

Ecuación de Schrödinger Electrón libre y barrera de potencial									
Electrón en pozo de potencial y									
en un potencial periódico									
Introducción a la Mecánica									
Estadística									
Estadística de portadores y nivel de Fermi									
Bandas de energía y									
distribuciones de portadores en									
semiconductores									
Bandas de energía y									
distribuciones de portadores en semiconductores									
Semiconductores intrínsecos									
Semiconductores extrínsecos									
Arrastre de portadores en									
presencia de campos eléctricos									
Difusión de portadores									
Difusión de portadores									
Ecuación de continuidad Estado estacionario de inyección									
de portadores									
Uniones Condiciones de equilibrio,									
Polarización directa e inversa									
Ruptura o Breakdown									
Desviaciones del modelo simple									
Uniones Metal-Semiconductor,									
barreras de Schottk									
Diodo de unión PN									
Diodo de unión y diodo túnel									
Modelaje en SPICE de la unión									
PN									
Nuevos dispositivos									
Dispositivos de heteroestructuras Dispositivos fotónicos									
Dispositivos noleculares									
2 is postar of moreovariates									

	VI. EVALUACIÓ	N	
	TIPO DE EVALUACIÓN	FECHA	PORCENTAJE
PRIMERA NOTA	Talleres, Trabajos, Quiz, Parcial	Hasta semana 6	35%
SEGUNDA	Talleres, Trabajos, Quiz, Parcial	Hasta semana 16	35%
EXAM. FINAL	Examen final	Semana 17 y 18	30 %

# ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO

- 1. Evaluación del desempeño docente
- 2. Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo, teórica/práctica, oral/escrita.

  3. Autoevaluación:
- 4. Coevaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente.

DATOS DEL DOCENTE			
ASESORIAS: FIRMA DE ESTUDI	ANTES		
NOMBRE	FIRMA	CÓDIGO	FECHA
TOMBRE	T TIKIVIT	Cobigo	Lem
1.			
2.			
3.			
3.			
FIRMA DEL DOCENTE			
FECHA DE ENTREGA:			